

بررسی اثر به کارگیری لایه های پیزوالکتریک بر ارتعاشات اجباری و آزاد ورق های FGM

محمد شرعیات (دانشیار)

ابمان امنیتی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در این نوشتار به منظور بررسی آثار ناشی از به کارگیری لایه های پیزوالکتریک حسگر و محرك، بر ارتعاشات ورق FGM^۱ چهارگوش، به مطالعه‌ی ارتعاشات آزاد، ارتعاشات اجباری و کنترل فعال ارتعاشات گذرا در این خصوص خراهمی پرداخت. در تحلیل ارتعاشات آزاد، مقادیر فرکانس طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی سیستم به دست آمدند. در تحلیل ارتعاشات اجباری، پاسخ سیستم به ازای ورودی‌های متفاوت و ولتاژهای مختلف اعمالی به لایه‌ی پیزوالکتریک به دست آمدند. برای حل معادلات حاکم، از روش اجزاء محدود بهره گرفته شده است. در نهایت، نتایج حاصله حاکی از آن بوده است که استفاده از لایه‌ی پیزوالکتریک تأثیر اندکی بر مقادیر فرکانس طبیعی داشته و بر شکل مودهای ارتعاشی بی‌تأثیر است. اما می‌توان از ویژگی لایه‌های پیزوالکتریک حسگر و محرك برای کنترل فعال ارتعاشات گذرا سیستم‌ها استفاده کرد بدون آن که بازنگری در پارامترهای ارتعاشی ضرورتی داشته باشد.

وازگان کلیدی: ارتعاشات، ورق FGM، پیزوالکتریک، کنترل فعال، روش اجراء محدود.

m_shariyat@yahoo.com
imanaminaee@yahoo.com

۱. مقدمه

کنترل ارتعاشات ورق FGM با استفاده از محرك و حسگر پیزوالکتریک و مدار کنترلی ساده بررسی شد.^[۱] در این بررسی از نظریه‌ی کلاسیک استفاده شد و رابطه‌ی خواص مکانیکی FGM در راستای ضخامت به صورت خطی منظور شد. سپس، رفتار استاتیکی یک پوسته‌ی عمومی FGM با لایه‌های پیزوالکتریک، با استفاده از نظریه‌ی مرتبه بالا مورد بررسی قرار گرفت.^[۲]

در سال ۲۰۰۳ نیز محققین دیگر ارتعاش ورق های FGM را تحت نیروهای درون‌صفحه‌یی و به روش نیمه‌تحلیلی بررسی کردند.^[۳] و بالاخره در سال ۲۰۰۵ اثر دما بر ارتعاش ورق FGM با استفاده از نظریه‌ی مرتبه بالا و بهشیوه‌ی نیمه‌تحلیلی بررسی شد.^[۴]

در تحقیق کنونی با استفاده از نظریه‌ی بشی مرتبه سوم برای میدان جایه‌جایی، و المان مرتبه دوم لاگرانژی با نقطه گره، معادلات اجراء محدود حاکم بر ارتعاشات گذرا و اجباری ورق FGM دارای لایه های حسگر و محرك به دست آمدند. حاصل این پژوهش کسب نتایجی درخصوص بررسی اثر لایه های پیزوالکتریک بر فرکانس‌های طبیعی در شرایط مرزی مختلف، اثر لایه های پیزوالکتریک بر پاسخ‌های اجباری ناشی از تحریک‌های پله‌یی و هارمونیک، و نیز اثر کنترل فعال پاسخ گذرا

ناشی از ورودی پالس است.

پیدایش مواد جدید یکی از عوامل مهمی است که باعث پیشرفت و گسترش صنایع در زمینه‌های مختلف شده است؛ دست‌یابی به موادی از قبیل FGMs و آلیاژهای حافظه‌دار همگنی می‌بین این مطلب است. یکی از تازه‌ترین دستاوردهای مهندسی سازه و مواد در زمینه‌ی سازه‌های هوشمند، مواد تطبیقی است. این سازه‌ها با استفاده از اثرات مستقیم و معکوس شرایطی را برای تطبیق سازه با محیط پیرامون خود فراهم می‌سازند. در این بین، پیزوالکتریک‌ها سهم بسیاری دارند. استفاده از FGMs ها موجب توزیع نتش یکنواخت در سازه می‌شود و مسائلی نظری جهش مؤلفه‌های تنش در مرز لایه‌ها، ترک خوردن ماتریس و دیگر مشکلات موجود در کامپوزیت‌های رشته‌ای را برطرف می‌سازد. ازسوی دیگر سازه‌های FGM با داشتن خواص قابلی شان هنگامی که با لایه‌یی از مواد پیزوالکتریک ترکیب شوند، ماده‌ی FGM با خواص کنترل‌پذیر به وجود خواهند آورد که کاربرد آن را مطلوب تراز پیش می‌سازد.

برخلاف تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی بررسی ارتعاشات ورق های کامپوزیتی، پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی ورق های FGM محدود بوده اند. در سال ۲۰۰۱،

تاریخ: دریافت ۱۶/۷/۱۳۸۶، داوری ۸/۸/۱۳۸۷، پذیرش ۱۰/۱۳۸۷.

۲. معادلات ورق FGM با لایه پیزوالکتریک

$$\begin{aligned}\gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \psi_y - \frac{4z^3}{h^3} \left(\frac{\partial w_0}{\partial y} + \psi_y \right) + \frac{\partial w_0}{\partial y} \\ \gamma_{xz} &= \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = \psi_x - \frac{4z^3}{h^3} \left(\frac{\partial w_0}{\partial x} + \psi_x \right) + \frac{\partial w_0}{\partial x} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial y} + z \frac{\partial \psi_x}{\partial y} - \frac{4z^3}{3h^3} \left(\frac{\partial^3 w_0}{\partial x \partial y} + \frac{\partial \psi_x}{\partial y} \right) \\ &\quad + \frac{\partial v_0}{\partial x} + z \frac{\partial \psi_y}{\partial x} - \frac{4z^3}{3h^3} \left(\frac{\partial^3 w_0}{\partial y \partial x} + \frac{\partial \psi_y}{\partial x} \right)\end{aligned}\quad (3)$$

در محاسبات، مؤلفه‌های کرنش به صورت چندجمله‌ی مرتبه ۳ بر حسب z مرتب می‌شوند.

$$\varepsilon = \varepsilon^0 + z\varepsilon^1 + z^2\varepsilon^2 + z^3\varepsilon^3 \quad (4)$$

برای محاسبه میدان الکتریکی می‌توان نوشت:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (5)$$

براین اساس، نتیجه‌ی حاصله عبارت است از:

$$\begin{aligned}E_x &= -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \left[\left(\frac{h - 2\bar{h}}{2\bar{h}} \right) \frac{\partial \varphi_T}{\partial x} + \left(\frac{-h}{2\bar{h}} \right) \frac{\partial \varphi_B}{\partial x} \right] \\ &\quad + z \left[\left(\frac{-1}{h} \right) \frac{\partial \varphi_T}{\partial x} + \left(\frac{1}{h} \right) \frac{\partial \varphi_B}{\partial x} \right] \\ E_y &= -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \left[\left(\frac{h - 2\bar{h}}{2\bar{h}} \right) \frac{\partial \varphi_T}{\partial y} + \left(\frac{-h}{2\bar{h}} \right) \frac{\partial \varphi_B}{\partial y} \right] \\ &\quad + z \left[\left(\frac{-1}{h} \right) \frac{\partial \varphi_T}{\partial y} + \left(\frac{1}{h} \right) \frac{\partial \varphi_B}{\partial y} \right] \\ E_z &= -\frac{\partial \varphi}{\partial z} = \left[\left(\frac{-1}{h} \right) \varphi_T + \left(\frac{1}{h} \right) \varphi_B \right]\end{aligned}\quad (6)$$

در محاسبات، میدان الکتریکی را می‌توان به صورت چندجمله‌ی مرتبه ۱ بر حسب z بیان کرد:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^0 + z\mathbf{E}^1 \quad (7)$$

معادلات حاکم بر سیستم از اصل همیلتون (رابطه ۸) به دست می‌آید:

$$\delta \int L dt = 0 \quad (8)$$

که در آن L چنین تعریف می‌شود:

$$L = \int (J - H)d\tilde{V} + W \quad (9)$$

یادآور می‌شود J انرژی جنبشی بر واحد حجم، H انرژی پتانسیل بر واحد حجم، W کار نیروهای خارجی وارد بر سیستم، و $d\tilde{V}$ المان حجم ورق است. با انجام محاسبات لازم، قانون همیلتون چنین به دست می‌آید:^[۶]

$$\int (\rho \delta \theta^T \ddot{\theta} + \delta \varepsilon^T \sigma - \delta \mathbf{E}^T \mathbf{D}) d\tilde{V} - \int \delta \theta^T \text{Tr} d\tilde{A} = 0 \quad (10)$$

که در آن θ بردار جابه‌جایی، ε بردار کرنش، σ بردار تنش، \mathbf{E} بردار میدان الکتریکی، \mathbf{D} بردار جابه‌جایی الکتریکی، Tr بردار تنش خارجی وارد بر سطح ورق، $d\tilde{A}$ المان سطح جانبی ورق و ρ چگالی مواد است. روابط حاکم بر ماده‌ی پیزوالکتریک عبارت‌اند از:

$$\begin{cases} \sigma = \mathbf{c}_p \varepsilon - \mathbf{e}^T \mathbf{E} \\ \mathbf{D} = \mathbf{e} \varepsilon + \mathbf{b} \mathbf{E} \end{cases} \quad (11)$$

پارامترهای هندسی و مؤلفه‌های جابه‌جایی ورق در شکل ۱ نشان داده شده است.

برای میدان جابه‌جایی از نظریه‌ی برشی مرتبه سوم (رابطه ۱) استفاده شده است.^[۵]

$$\begin{aligned}u &= u_0 + z\psi_x - \frac{4z^3}{3h^3} \left(\frac{\partial w_0}{\partial x} + \psi_x \right) \\ v &= v_0 + z\psi_y - \frac{4z^3}{3h^3} \left(\frac{\partial w_0}{\partial y} + \psi_y \right) \\ w &= w_0.\end{aligned}\quad (11)$$

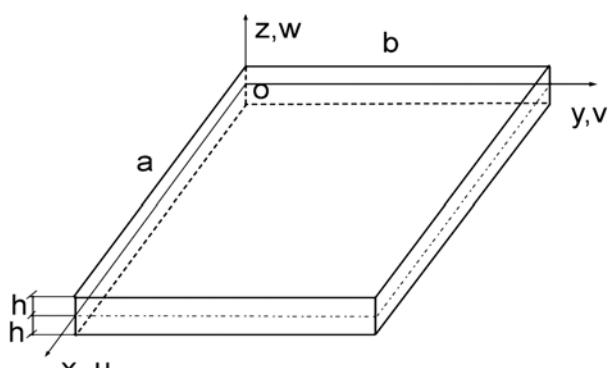
که در آن w, v, u : جابه‌جایی نقاط ورق در راستای محورهای Z, Y, X ؛ w_0, v_0, u_0 : جابه‌جایی نقاط واقع بر صفحه‌ی میانی ورق در راستای محورهای Z, Y, X ؛ ψ_x, ψ_y : دوران نقاط واقع بر لبه‌های موازی Y, X صفحه‌ی میانی ورق حول محورهای X, Y ؛ z : متغیر مستقل در راستای ضخامت؛ h : کل ضخامت ورق.

تغییرات میدان ولتاژ در راستای ضخامت ورق به صورت خطی و مطابق رابطه ۲ در نظر گرفته شده است:

$$\varphi = \left[\left(\frac{2\bar{h} - h}{2\bar{h}} \right) \varphi_T + \left(\frac{h}{2\bar{h}} \right) \varphi_B \right] + z \left[\left(\frac{1}{h} \right) \varphi_T + \left(\frac{-1}{h} \right) \varphi_B \right] \quad (2)$$

که در آن φ_T پتانسیل الکتریکی روی صفحات بالایی ورق، φ_B پتانسیل الکتریکی روی صفحات پایینی ورق و \bar{h} ضخامت لایه‌ی پیزوالکتریک است. برای محاسبات از روابط کرنش - جابه‌جایی خطی استفاده شده است. اگر روابط میدان جابه‌جایی ۱ در روابط کرنش - جابه‌جایی قرار داده شود، آنگاه:

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial x} + z \frac{\partial \psi_x}{\partial x} - \frac{4z^3}{3h^3} \left(\frac{\partial^3 w_0}{\partial x^3} + \frac{\partial \psi_x}{\partial x} \right) \\ \varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v_0}{\partial y} + z \frac{\partial \psi_y}{\partial y} - \frac{4z^3}{3h^3} \left(\frac{\partial^3 w_0}{\partial y^3} + \frac{\partial \psi_y}{\partial y} \right) \\ \varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial w_0}{\partial z} = 0.\end{aligned}$$



شکل ۱. پارامترهای هندسی و مؤلفه‌های جابه‌جایی ورق مورد بررسی.

انرژی پتانسیل ناشی از میدان الکتریکی - جایه‌جایی الکتریکی که فقط در لایه‌ی پیزاالکتریک وجود دارد، نیز مطابق رابطه‌ی ۱۸ محاسبه می‌شود.

$$\int \delta \mathbf{E}^T \mathbf{D} d\tilde{V} = \int \delta \mathbf{V}^T (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge)^T [\mathbf{e}(\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_E^\circ + z^\wedge \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{U} + \mathbf{b}(\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{V}] d\tilde{V} \quad (18)$$

کار نیروی خارجی وارد بر لایه‌ی ورق را می‌توان مطابق رابطه‌ی ۱۹ محاسبه کرد.

$$\int \delta \theta^T \mathbf{T} \mathbf{r} d\tilde{A} = \int \delta \mathbf{U}^T (\mathbf{L}_\theta^\circ + z \mathbf{L}_\theta^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_\theta^\circ)^T \mathbf{T} \mathbf{r} d\tilde{A} \quad (19)$$

با تعریف نمادهای زیر، می‌توان روابط را ساده کرد.

$$\begin{aligned} \rho_i &= \int_{-\frac{h}{4}}^{\frac{h}{4}} \rho z^i dz \\ \mathbf{c}_i &= \int_{-\frac{h}{4}}^{\frac{h}{4}} \mathbf{c} z^i dz \\ \mathbf{e}_i &= \int_{-\frac{h}{4}}^{\frac{h}{4}} \mathbf{e} z^i dz \\ \mathbf{b}_i &= \int_{-\frac{h}{4}}^{\frac{h}{4}} \mathbf{b} z^i dz \end{aligned} \quad (20)$$

برای آن که روابط بالا مناسب کاربرد در حل عددی باشند، باید توابع تقریب را مطابق رابطه‌ی ۲۱ به ماتریس توابع شکل و مقادیر کمیت‌ها در نقاط گره ارتباط داد. در محاسبات از المان چهارگوش لاگرانژی مرتبه دوم با ۹ نقطه گره استفاده شده است.

$$\mathbf{U} = \mathbf{N}_U \bar{\mathbf{U}}$$

$$\mathbf{V} = \mathbf{N}_V \bar{\mathbf{V}} \quad (21)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}_U &= \begin{bmatrix} N_i & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & N_i & \circ & \circ & \circ \\ \dots & \circ & \circ & N_i & \circ \\ \circ & \circ & \circ & N_i & \circ \\ \circ & \circ & \circ & \circ & N_i \end{bmatrix} \\ \mathbf{U}^T &= \left\{ \bar{u}_0, \bar{v}_0, \bar{w}_0, \bar{\psi}_x, \bar{\psi}_y \right\} \\ \mathbf{N}_V &= \begin{bmatrix} \dots & N_i & \circ \\ \circ & \dots & N_i \end{bmatrix} \\ \bar{\mathbf{V}}^T &= \left\{ \bar{\varphi}_T, \bar{\varphi}_B \right\} \end{aligned} \quad (22)$$

و \circ شمارنده است.

برای برقراری ارتباط میان بردارهای کرنش، میدان الکتریکی و جایه‌جایی با بردار مقادیر نقاط گره، می‌توان از عملگرهای کمکی مطرح شده در رابطه‌ی ۲۳ استفاده کرد.

$$\begin{aligned} \varepsilon &= (\mathbf{B}_\varepsilon^\circ + z \mathbf{B}_\varepsilon^\wedge + z^\circ \mathbf{B}_\varepsilon^\circ + z^\wedge \mathbf{B}_\varepsilon^\wedge) \bar{\mathbf{U}} \\ \mathbf{E} &= (\mathbf{B}_E^\circ + z \mathbf{B}_E^\wedge) \bar{\mathbf{V}} \\ \theta &= (\mathbf{B}_\theta^\circ + z \mathbf{B}_\theta^\wedge + z^\circ \mathbf{B}_\theta^\circ) \bar{\mathbf{U}} \end{aligned} \quad (23)$$

که در آن \mathbf{c}_p ماتریس سختی ماده‌ی پیزاالکتریک، \mathbf{e} ماتریس کوبیل الکترومکانیکی و \mathbf{b} ماتریس گذردهی الکتریکی است. تغییرات ویژگی‌های مکانیکی ماده‌ی FGM برحسب فاصله از لایه‌ی مرتع چنین تعیین می‌شود:

$$P(z) = (P_t - P_b) \left(\frac{z + h/2}{h - h} \right)^n + P_b \quad (12)$$

که در آن P_t ویژگی‌های مکانیکی مواد ایزوتropیک لایه‌ی روین، P_b ویژگی‌های مکانیکی مواد ایزوتropیک لایه‌ی زیرین است. اگر $n = 1$ باشد، رابطه‌ی ۱۲ خطی است و اگر $n \neq 1$ باشد این رابطه غیرخطی خواهد بود. در این رابطه فرض شده است که فقط از یک لایه‌ی پیزاالکتریک، که بر روی مجموعه قرار داده شده، استفاده می‌شود و نیز ماده‌ی FGM از ترکیب دو ماده ساخته شده است. از طریق رابطه‌ی ۱۲ می‌توان خصوصیات مکانیکی مواد - نظری مدول الاستیستیته، چگالی حجمی و غیره - را در هر نقطه از ضخامت ورق محاسبه، و از طریق روابط ماتریس سختی و نرمی مواد ایزوتropیک، ماتریس سختی و نرمی را نیز محاسبه کرد. بردار کرنش برحسب بردار توابع تقریب مکانیکی، مطابق رابطه‌ی ۱۳ تعریف می‌شود:

$$\varepsilon = (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_E^\circ + z^\wedge \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{U} \quad (13)$$

که در آن \mathbf{L}_E° عملگر کمکی کرنشی است و بردار توابع تقریب مکانیکی به صورت $\{\psi_x, \psi_y, \psi_w, \psi_v\}$ تعریف می‌شود. رابطه‌ی بردار میدان الکتریکی برحسب بردار توابع تقریب الکتریکی چنین است:

$$\mathbf{E} = (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{V} \quad (14)$$

که در آن \mathbf{L}_E° عملگر کمکی میدان الکتریکی است و بردار توابع تقریب الکتریکی به صورت $\{\varphi_T, \varphi_B\}$ تعریف می‌شود. اما بردار جایه‌جایی برحسب بردار توابع تقریب مکانیکی نیز چنین بیان می‌شود:

$$\theta = (\mathbf{L}_\theta^\circ + z \mathbf{L}_\theta^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_\theta^\circ) U \quad (15)$$

که در آن \mathbf{L}_θ° عملگر کمکی جایه‌جایی است، و بردار توابع تقریب مکانیکی به صورت $\{u_0, v_0, w_0, \psi_x, \psi_y\}$ تعریف می‌شود. انرژی جنبشی لایه‌ها مطابق رابطه‌ی ۱۶:

$$\int \rho \delta \theta^T \ddot{\theta} d\tilde{V} = \sum \int \rho \delta \mathbf{U}^T (\mathbf{L}_\theta^\circ + z \mathbf{L}_\theta^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_\theta^\circ)^T (\mathbf{L}_\theta^\circ + z \mathbf{L}_\theta^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_\theta^\circ) \ddot{\mathbf{U}} d\tilde{V} \quad (16)$$

و انرژی کرنشی مطابق رابطه‌ی ۱۷ محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} \int \delta \varepsilon^T \sigma d\tilde{V} &= \int \delta \mathbf{U}^T (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_E^\circ + z^\wedge \mathbf{L}_E^\wedge)^T [\mathbf{c}_p (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_E^\circ + z^\wedge \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{U} \\ &\quad - \mathbf{e}^T (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{V}] d\tilde{V} + \sum \int \delta \mathbf{U}^T (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_E^\circ + z^\wedge \mathbf{L}_E^\wedge)^T [\mathbf{c}_c (\mathbf{L}_E^\circ + z \mathbf{L}_E^\wedge + z^\circ \mathbf{L}_E^\circ + z^\wedge \mathbf{L}_E^\wedge) \mathbf{U}] d\tilde{V} \end{aligned} \quad (17)$$

که در آن:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{UU}^t & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{U}}_t \\ \bar{\mathbf{V}}_t \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{UU}^t & \mathbf{K}_{UV}^t \\ \mathbf{K}_{VU}^t & \mathbf{K}_{VV}^t \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{U}}_t \\ \bar{\mathbf{V}}_t \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_U^t \\ \cdot \end{Bmatrix} \quad (29)$$

برای لایه‌ی پیزوالکتریک می‌توان دو نقش حسگر و محرک قائل شد، و با حل رابطه‌ی ۲۹ به نتایج مورد نظر دست یافت.

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_\varepsilon^i &= \mathbf{L}_\varepsilon^i \mathbf{N}_U \\ \mathbf{B}_E^i &= \mathbf{L}_E^i \mathbf{N}_V \\ \mathbf{B}_\theta^i &= \mathbf{L}_\theta^i \mathbf{N}_U \end{aligned} \quad (24)$$

با استفاده از رابطه‌های ۲۳ و ۲۴، معادله‌ی حاکم بر سیستم برای هر المان چنین خواهد بود:

$$\mathbf{M}^e \ddot{\mathbf{\Omega}}_e + \mathbf{K}^e \bar{\mathbf{\Omega}}_e = \mathbf{F}^e \quad (25)$$

رابطه‌ی ۲۵ در حالت گستردگی عبارت است از:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{UU}^e & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{U}}_e \\ \bar{\mathbf{V}}_e \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{UU}^e & \mathbf{K}_{UV}^e \\ \mathbf{K}_{VU}^e & \mathbf{K}_{VV}^e \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{U}}_e \\ \bar{\mathbf{V}}_e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_U^e \\ \cdot \end{Bmatrix} \quad (26)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{UU}^e &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (\mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\theta \mathbf{B}_\theta^e + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\lambda \mathbf{B}_\theta^\lambda + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\tau \mathbf{B}_\theta^\tau \\ &\quad + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\lambda \mathbf{B}_\theta^\lambda + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\tau \mathbf{B}_\theta^\tau + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\tau \mathbf{B}_\theta^\tau \\ &\quad + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\tau \mathbf{B}_\theta^\tau + \mathbf{B}_\theta^{eT} \rho_\tau \mathbf{B}_\theta^\tau) J d\zeta d\eta \\ \mathbf{K}_{UU}^e &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (\mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\varepsilon \mathbf{B}_\varepsilon^e + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\lambda \mathbf{B}_\varepsilon^\lambda + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\tau \mathbf{B}_\varepsilon^\tau \\ &\quad + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\tau \mathbf{B}_\varepsilon^\tau + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\lambda \mathbf{B}_\varepsilon^\lambda + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\tau \mathbf{B}_\varepsilon^\lambda \\ &\quad + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\lambda \mathbf{B}_\varepsilon^\lambda + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\tau \mathbf{B}_\varepsilon^\tau + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\lambda \mathbf{B}_\varepsilon^\tau \\ &\quad + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\lambda \mathbf{B}_\varepsilon^\tau + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\tau \mathbf{B}_\varepsilon^\lambda + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{c}_\tau \mathbf{B}_\varepsilon^\tau) J d\zeta d\eta \\ \mathbf{K}_{UV}^e &= - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\varepsilon^T \mathbf{B}_E^e + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\lambda^T \mathbf{B}_E^\lambda \\ &\quad + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\tau^T \mathbf{B}_E^\lambda + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\tau^T \mathbf{B}_E^\tau + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\lambda^T \mathbf{B}_E^\tau \\ &\quad + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\tau^T \mathbf{B}_E^\tau + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\tau^T \mathbf{B}_E^\lambda + \mathbf{B}_\varepsilon^{eT} \mathbf{e}_\lambda^T \mathbf{B}_E^\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{VU}^e &= \mathbf{K}_{UV}^{eT} \\ \mathbf{K}_{VV}^e &= - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (\mathbf{B}_E^{eT} \mathbf{b}_\varepsilon \mathbf{B}_E^e + \mathbf{B}_E^{eT} \mathbf{b}_\lambda \mathbf{B}_E^\lambda + \mathbf{B}_E^{eT} \mathbf{b}_\tau \mathbf{B}_E^\tau \\ &\quad + \mathbf{B}_E^{eT} \mathbf{b}_\lambda \mathbf{B}_E^\lambda) J d\zeta d\eta \\ \mathbf{F}_U^e &= \int_{-\frac{h}{4}}^{\frac{h}{4}} \int_{-1}^1 (\mathbf{B}_\theta^e + z \mathbf{B}_\theta^\lambda + z^\tau \mathbf{B}_\theta^\tau)^T \mathbf{Tr} J d\eta dz \end{aligned} \quad (27)$$

ماتریس‌های جرم، سختی و نیروی کلی سازه از ترکیب ماتریس‌های جرم، سختی و نیروی المان‌ها به دست می‌آیند.

$$\mathbf{M}^t \ddot{\mathbf{\Omega}}_t + \mathbf{K}^t \bar{\mathbf{\Omega}}_t = \mathbf{F}^t \quad (28)$$

۴. نتایج به دست آمده

۱.۴. ارتعاش آزاد

ورق اولیه‌ی مورد بررسی، یک ورق چهارگوش بمقاييس $20\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 4\text{ mm}$ و یک لایه ماده‌ی پیزوالکتریک به ضخامت از ماده‌ی FGM

که در آن، $\{\bar{\mathbf{V}}_t\}_a$ ولتاژ لایه‌ی محرک است و در تحقیق کنونی معادل است با:

$$\{\bar{\mathbf{V}}_t\}_a = -gain \times \{\bar{\mathbf{V}}_t\}_s \quad (35)$$

مقدار gain ثابت است و میزان مناسب آن از طریق تحلیل‌های متوالی به دست می‌آید.

۵. نتایج به دست آمده

۱.۴. ارتعاش آزاد

ورق اولیه‌ی مورد بررسی، یک ورق چهارگوش بمقاييس $20\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 4\text{ mm}$ و یک لایه ماده‌ی پیزوالکتریک به ضخامت

تائید نتایج روابط ارائه شده در این نوشتار و انتخاب نوع و تعداد مناسب المان، نتایج حاصله برای پنج فرکانس طبیعی اول ورق FGM بدون لایه های پیزوالکتریک با چهار لایه گیردار برای مرتبه و تعداد گوناگونی از المان ها به دست آمده و با نتایج نرم افزار ANSYS مقایسه شدند. در این زمینه، پنج گونه المان بندی برای ورق در نظر گرفته شد:

۱. ۳۶ المان مرتبه اول لاگرانزی؛
۲. ۱۰۰ المان مرتبه اول لاگرانزی؛
۳. ۴۰۰ المان مرتبه اول لاگرانزی؛
۴. ۱۶ المان مرتبه دوم لاگرانزی؛
۵. ۳۶ المان مرتبه دوم لاگرانزی.

در جدول ۳ نتایج به دست آمده از پنج نوع المان بندی یاد شده، با نتایج نرم افزار ANSYS که بر پایه ۳۶ المان مرتبه دوم به دست آمده، مقایسه شده اند. چنان که ملاحظه می شود، بالاترین دقت نتایج کنونی به ازاء به کار گیری ۳۶ المان مرتبه دوم لاگرانزی به دست آمده است. در این حالت، پیشترین تطابق با نتایج نرم افزار ANSYS حاصل شده است. به همین دلیل برای دیگر محاسبات نوشتار نیز از این نوع المان با تعداد یاد شده، استفاده شد. اختلاف پدید آمده میان دقیق ترین نتایج کنونی و نتایج نرم افزار ANSYS ناشی از خطای برنامه نیست. در نرم افزار ANSYS از نظریه کلاسیک برای تقریب تغییرات میدان جابه جایی استفاده شده است، حال آن که در برنامه هی حل عددی نوشته شده از نظریه مرتبه بالا (مرتبه سوم) برای توصیف تغییرات میدان جابه جایی استفاده شده است. بیشینه اختلاف نتایج این نظریه، براساس نتایج جدول ۳، برای تحلیل یاد شده ۱۰ درصد بوده است. تحلیل های ارتعاش آزاد انجام شده، یافتن مقادیر فرکانس طبیعی و شکل مدهای ارتعاشی را شامل می شوند.

مقادیر فرکانس طبیعی بر حسب هر تر برای شرایط مرزی مختلف، به ازاء $n = 1$ در جدول ۴ ارائه شده اند. نمادهای F , A , FP , S , E_t و E_b به ترتیب، بیان گر ورق FGM بدون لایه پیزوالکتریک، ورق دارای لایه پیزوالکتریک، محرك و حسنگر هستند. منظور از لایه پیزوالکتریک محرك در جدول ۳، لایه پیزوالکتریک اتصال کوتاه شده است. در حالت کلی، یافتن فرکانس های طبیعی ورق دارای لایه پیزوالکتریک محرك از طریق تحلیل زمانی - و نه حل مسئله مقادیر ویژه - امکان پذیر است.

جدول ۳. نتایج به دست آمده برای پنج فرکانس طبیعی اول ورق FGM، بر حسب هر تر، با انتخاب تعداد و مرتبه متفاوت برای المان ها، و مقایسه ای آنها با نتایج نرم افزار ANSYS.

ANSYS المان ۳۶)	المان چهارگوش مرتبه دوم		المان چهارگوش مرتبه اول			شماره مود
	۳۶	۱۶	۴۰۰	۱۰۰	۳۶	
۱۳۰۶	۱۳۷۵	۱۴۵۷	۱۵۷۳	۲۱۲۶	۳۰۹۸	۱
۲۶۷۲	۲۹۴۱	۳۳۱۹	۳۱۸۲	۴۱۳۳	۵۹۸۲	۲
۲۷۴۵	۲۹۴۲	۳۳۹۹	۳۵۷۳	۵۴۱۰	۸۷۷۲	۳
۳۸۵۰	۴۳۴۲	۴۹۷۱	۴۸۳۰	۶۶۰۵	۹۹۵۷	۴
۵۲۸۰	۵۷۴۹	۱۰۹۰۰	۶۸۷۲	۱۱۱۲۳	۱۸۸۷۶	۵

۰/۲mm تشکیل شده است. نتایج براساس شرایط مرزی دسته بندی شده اند. شرایط مرزی انتخاب شده برای حل مسئله شامل: چهارسر گیردار (CCOC)، یکسر گیردار و سه سر آزاد (CFFF)، دو سر گیردار و دو سر مفصل (CCSS)، دو سر مفصل و دو سر آزاد (SSFF) و چهارسر مفصل (SSSS) است. بنابراین، شرایط مرزی منتخب ترکیبی است از سه حالت:

۱. لبه گیردار که با نماد C نمایش داده می شود؛
۲. لبه روی تکیه گاه مفصلی که با نماد S نمایش داده می شود؛
۳. لبه آزاد که با نماد F نمایش داده می شود.

در حالت اول برای اعمال شرط مرزی در لبه مورد نظر هر پنج درجه آزادی ψ_y , v_y , w_y , ψ_x , v_x , w_x برابر صفر فرض می شوند. در حالت دوم برای اعمال شرط مرزی در لبه مورد نظر w_y , v_y , w_x برابر صفر فرض می شوند؛ همچنین اگر لبه مورد نظر موازی محور X باشد ψ_x آزاد و ψ_y برابر با صفر قرار داده می شود. در حالت سوم، در لبه مورد نظر هر پنج درجه آزادی ψ_y , v_y , w_y , ψ_x , v_x , w_x آزادند.

ماده FGM مورد استفاده از نوع آلومینیم - الومینیا است که ویژگی های مکانیکی آن در جدول ۱ داده شده اند؛ ماده پیزوالکتریک مورد استفاده نیز از نوع PZT-5A است که ویژگی های مکانیکی آن در جدول ۲ آورده شده اند. برای

جدول ۱. ویژگی های مکانیکی ماده FGM.

FGM	ویژگی مکانیکی ماده	مقدار
E_t	$۳۸^{\circ}(GPa)$	
E_b	$۷^{\circ}(GPa)$	
ρ_t	$۳۹\cdot۰(\frac{Kg}{m^۳})$	
ρ_b	$۲۷\cdot۰(\frac{Kg}{m^۳})$	
v	$۰/۳$	

جدول ۲. ویژگی های مکانیکی ماده پیزوالکتریک.

کمیت	مقدار
c_{11}	$۸۶/۸۵۶(GPa)$
c_{12}	$۵۰/۷۸۸(GPa)$
c_{21}	$۵۰/۷۸۸(GPa)$
c_{22}	$۹۹/۲۰۱(GPa)$
c_{32}	$۲۲/۶(GPa)$
c_{44}	$۲۱/۱(GPa)$
c_{55}	$۲۱/۱(GPa)$
e_{11}	$۱۵/۱۱۵(\frac{C}{m^۳})$
e_{12}	$-۷/۲۰۹(\frac{C}{m^۳})$
e_{25}	$۱۲/۳۲۲(\frac{C}{m^۳})$
e_{34}	$۱۲/۳۲۲(\frac{C}{m^۳})$
b_{11}	$۱۵(\frac{nF}{m})$
b_{22}	$۱۵/۳(\frac{nF}{m})$
b_{33}	$۱۵/۳(\frac{nF}{m})$
ρ	$۷۷۵(\frac{Kg}{m^۳})$

چنان که ملاحظه می‌شود در حالتی که $n = 5/5 = 0$ است ورق دارای بالاترین مقادیر فرکانس طبیعی است. پس از آن، حالت متناظر با $n = 2$ دارای بیشترین مقادیر فرکانس طبیعی است و در نهایت، حالت متناظر با کمترین مقدار فرکانس طبیعی را دارد.

۲.۴. ارتعاشات اجباری سیستم

در این بخش، پاسخ سیستم به ازاء دو نوع ورودی زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف) ورودی پله‌یی:

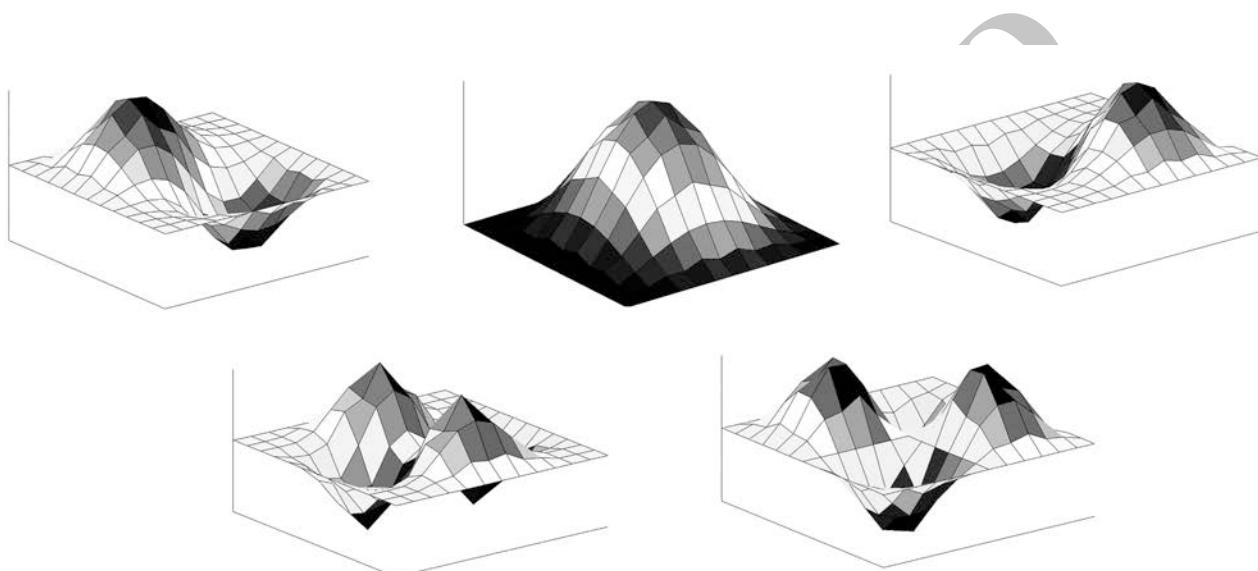
$$F(t) = 1000 [N], \quad t > 0 \quad (36)$$

ب) ورودی هارمونیک با فرکانس تحریک ۱۰۰ هرتز:

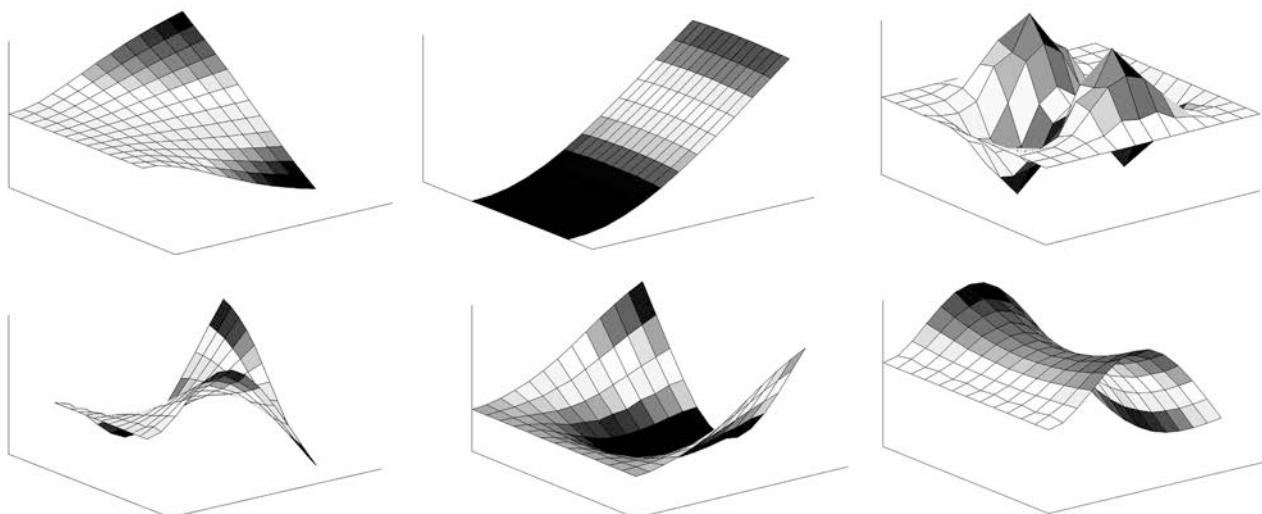
$$F(t) = 1000 \cdot \sin(100t) [N], \quad t > 0 \quad (37)$$

در شکل‌های ۲ تا ۶، پنج مود اول ارتعاش آزاد ورق‌های یادشده آورده شده است. نسبت ابعاد ورق و شرایط مرزی از عوامل مؤثر بر شکل مود ارتعاشی هستند، و نوع ماده‌ی ورق در شکل مودهای ارتعاشی تأثیری ندارد. بنابراین لایه‌ی پیازوالکتریک تأثیری بر شکل مودهای ارتعاشی ندارد.

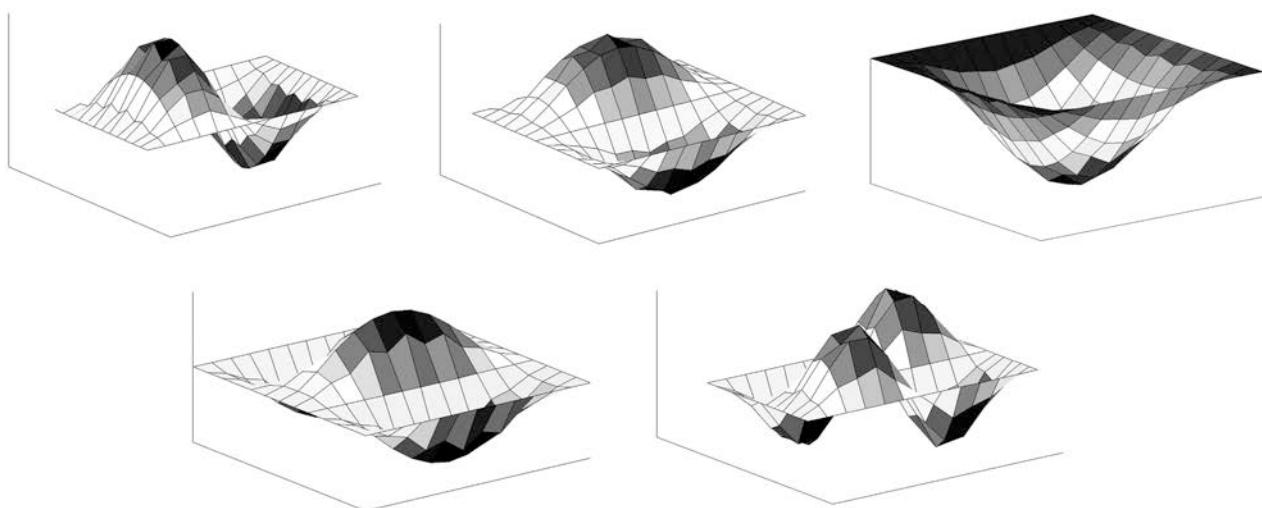
مقایسه‌ی مقدار پنج فرکانس طبیعی اول، برای ورق کامپوزیت بدون لایه‌ی پیازوالکتریک، با لایه‌ی پیازوالکتریک حسگر (مدار بازا) و با لایه‌ی پیازوالکتریک اتصال کوتاه شده، نشان می‌دهد که مقدار فرکانس‌های طبیعی به ترتیب متناظر با شرایط مرزی چهار سرگیردار، دو سرگیردار و دو سرمهصل، چهار سرمهصل، دو سرمهصل و دو سر آزاد و در نهایت یک سرگیردار و سه سر آزاد کاوش می‌یابند. اثر افزایش ابعاد ورق (با ثابت نگه داشتن مقدار ضخامت ورق) بر کاهش فرکانس طبیعی اول ورق چهار لبه‌گیردار در جدول ۵ بررسی شده است. همچنین اثر توان معادله‌ی حاکم بر رفتار مواد (رابطه‌ی ۱۲) بر فرکانس طبیعی اول، برای چند توان مختلف در جدول ۶ بررسی شده است.



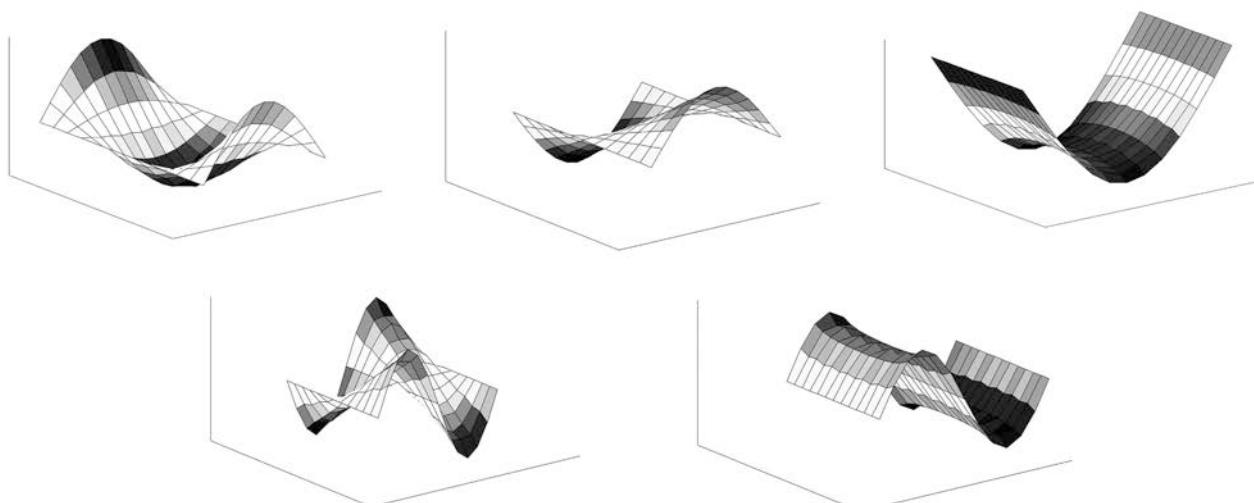
شکل ۲. شکل مودهای ارتعاشی حالت (CCCC).



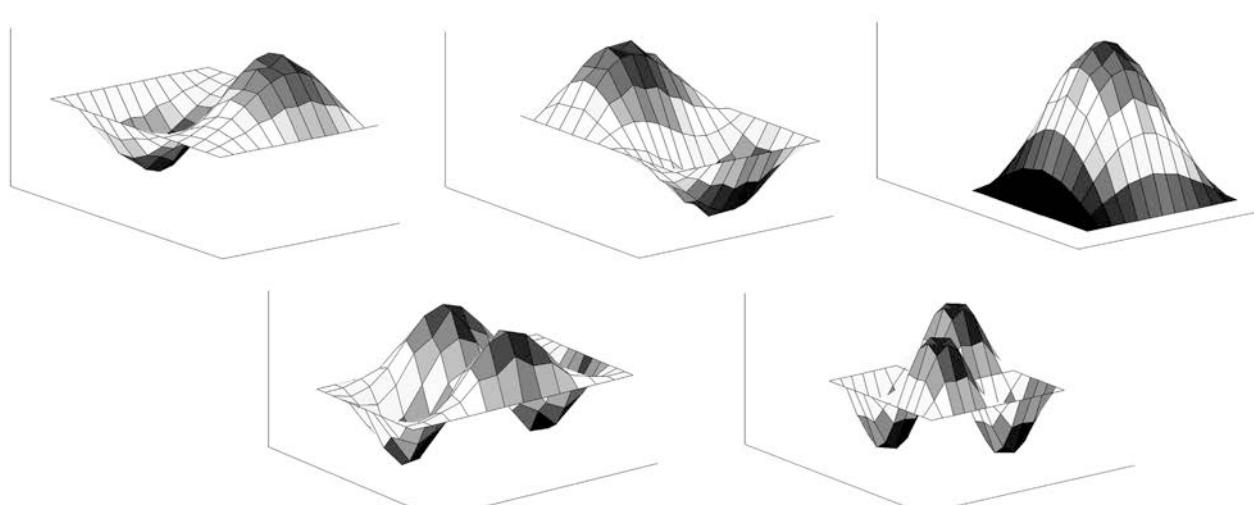
شکل ۳. شکل مودهای ارتعاشی حالت (CFFF).



شکل ۴. شکل مودهای ارتعاشی حالت (CCSS).



شکل ۵. شکل مودهای ارتعاشی حالت (SSFF).



شکل ۶. شکل مودهای ارتعاشی حالت (SSSS).

مالحظه‌بی در دامنه‌ی ارتعاشات پدید آورد. از سوی دیگر، ایجاد میدان الکتریکی نامطلوب، ممکن است به افزایش دامنه‌ی ارتعاشات بینجامد. چنان که مشاهده می‌شود از آنجا که میرایی سازه‌ی ورق نادیده گرفته شده است، شوک الکتریکی اولیه واردہ برایه‌ی پیزوالکتریک در اثر برقراری جریان الکتریکی، ارتعاشات گذرا نامیرایی در آن ایجاد کرده که بر ارتعاشات گذرا نامیرایی ورق سور است. همان‌طور که در شکل ۷ مشاهده می‌شود، ارتعاش کلی ورق با فرکانسی تقریباً برابر با فرکانس اول حالت ۳ از جدول ۳ انجام می‌پذیرد. همچنین، اثر ترکیب مودهای بعدی نیز در پاسخ آشکار است.

۲.۲.۴. ورودی هارمونیک

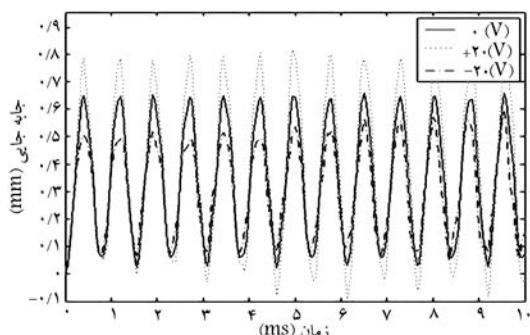
در شکل ۸ پاسخ ورق FGM بدون تحریک الکتریکی و با نیروی متغیر هارمونیک با فرکانس تحریک 100 هرتز، به همراه پاسخ آن بهمازه دو تحریک پیزوالکتریک

جدول ۵. اثر افزایش ابعاد ورق بر کاهش فرکانس‌های طبیعی.

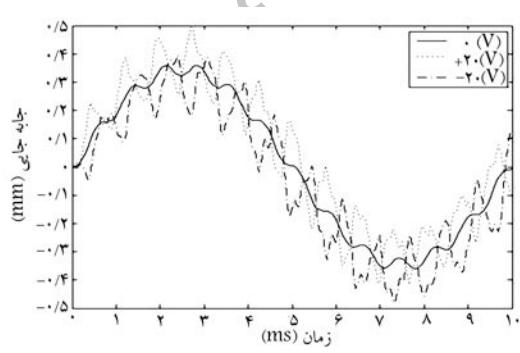
Cm*Cm	ابعاد ورق	F	FP(S)	FP (A)
$20 * 20$		۱۳۷۵	۱۲۳۱	۱۳۲۸
$40 * 40$		۳۴۷	۳۳۶	۳۳۵
$60 * 60$		۱۵۴	۱۵۰	۱۴۹

جدول ۶. اثر توان معادله‌ی حاکم بر رفتار مواد FGM، بر فرکانس‌های طبیعی ورق.

n	F	FP(S)	FP(A)
۱	۱۳۷۵	۱۲۳۱	۱۳۲۸
0.5	۱۵۲۱	۱۴۷۵	۱۴۷۲
۲	۱۲۵۲	۱۲۱۰	۱۲۰۸



شکل ۷. پاسخ ورق به ازاء ورودی پله‌ی.



شکل ۸. پاسخ ورق در ازای ورودی پله‌ی.

جدول ۴. مقادیر فرکانس طبیعی متناظر با شرایط مرزی مختلف.

شماره مود	F	FP(S)	FP(A)
حالات (CCCC)			
۱	۱۳۷۵	۱۲۳۱	۱۳۲۸
۲	۲۹۴۱	۲۸۴۵	۲۸۳۹
۳	۲۹۴۲	۲۸۴۸	۲۸۴۴
۴	۴۲۴۲	۴۲۰۱	۴۱۹۳
۵	۵۷۴۹	۵۵۵۸	۵۵۴۸
حالات (CFFF)			
۱	۱۲۷	۱۲۴	۱۲۴
۲	۳۱۳	۳۰۲	۳۰۰
۳	۷۹۹	۷۷۳	۷۶۹
۴	۱۰۰۶	۹۷۳	۹۷۱
۵	۱۱۵۶	۱۱۱۷	۱۱۱۲
حالات (CCSS)			
۱	۱۱۰۵	۱۰۶۷	۱۰۶۴
۲	۲۰۸۱	۲۰۱۱	۲۰۰۸
۳	۲۷۸۶	۲۶۹۵	۲۶۸۶
۴	۳۷۱۱	۳۵۸۶	۳۵۷۷
۵	۴۰۴۰	۳۸۹۹	۳۸۹۶
حالات (SSFF)			
۱	۳۸۰	۲۶۱	۳۵۹
۲	۶۰۶	۵۸۲	۵۷۸
۳	۱۳۵۶	۱۳۰۹	۱۳۰۴
۴	۱۴۷۷	۱۴۳۰	۱۴۲۴
۵	۱۷۷۱	۱۷۰۸	۱۷۰۱
حالات (SSSS)			
۱	۷۶۷	۷۲۱	۷۲۹
۲	۱۸۷۱	۱۸۰۳	۱۷۹۸
۳	۱۸۷۲	۱۸۰۴	۱۸۰۲
۴	۲۹۸۴	۲۸۷۵	۲۸۶۸
۵	۳۸۸۵	۳۷۵۳	۳۷۴۴

شرایط مرزی ورق در این حالت چهار لبه گیردار یا CCCC است. دامنه‌ی بار معادل 1 کیلونیوتون است و این بار بر نقطه‌ی میانی ورق و در راستای عمدت بر سطح آن اعمال می‌شود.

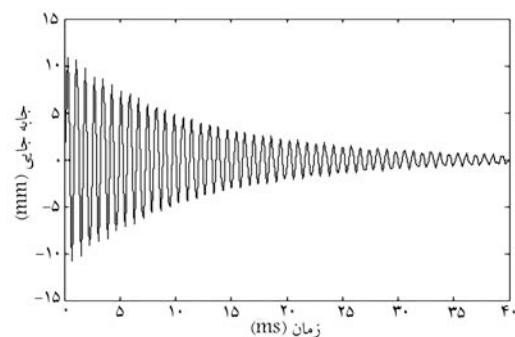
۱.۲.۴. ورودی پله‌ی

در این قسمت نتایج حاصل از ورودی پله‌ی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. با توجه به نتایج گذشته، وجود لایه‌ی پیزوالکتریک و همچنین اعمال ولتاژهای گوناگون، تأثیر اندکی بر مقادیر فرکانس طبیعی ورق دارد. در ولتاژهای اعمالی بزرگ‌تر، این اثر مشهودتر است. در شکل ۷، اثر تک‌لایه‌ی پیزوالکتریک بر دامنه‌ی ارتعاشات ورق FGM نشان داده شده است. چنان‌که از شکل ۷ پیداست، اعمال ولتاژ مناسب به تک‌لایه‌ی پیزوالکتریک ممکن است سختی ورق را افزایش دهد و کاهش قابل

به لایه‌ی محرک، ۵۰- در نظر گرفته شده است. بار واردہ به ورق، یک پالس با شدت ۱ کیلوبیوتون و در نقطه‌ی میانی ورق در نظر گرفته شده است. اثر کنترل فعال بر ارتعاشات ورق در شکل ۹ نشان داده شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، با وجود نادیده‌گرفتن میرایی سازه‌یی، ارتعاشات ورق از طریق بهکارگیری لایه‌های پیزوالکتریک میرا شده است.

۵. نتیجه‌گیری

در نوشتار کنونی، از نظریه‌ی تغییر شکل برشی مرتبه سوم برای میدان جابه‌جایی استفاده شده و برای المان بندی ورق از المان‌های مرتبه دو با ۹ نقطه‌گره بهره گرفته شده است. بنابراین نتایج بهدست آمده از دقت بالایی برخوردارند. در این نوشتار ورق مربعی از جنس مواد FGM که توسط یک یا دو لایه از مواد پیزوالکتریک پوشانده شده بود، مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت این نتیجه حاصل شد که لایه‌ی پیزوالکتریک تأثیر اندکی بر مقادیر فرکانس طبیعی ورق دارد. توان اختلاط مواد (n) و نسبت ابعاد درون صفحه‌یی به ضخامت، از جمله عوامل مؤثر بر فرکانس‌های طبیعی‌اند. استفاده از ولتاژ ثابت در لایه‌های پیزوالکتریک محرک می‌تواند دامنه‌ی ارتعاشات را کاهش دهد ولی ارتعاشات را میرا نمی‌سازد و اغتشاشاتی را در پاسخ به همراه خواهد داشت. فقط با استفاده‌ی همزمان از یک لایه‌ی پیزوالکتریک حس‌گر و دستکم یک لایه‌ی پیزوالکتریک محرک می‌توان به کنترل فعال ارتعاشات پرداخت و ارتعاشات پدیدآمده را میرا ساخت.



شکل ۹. کنترل ارتعاشات ورق FGM.

مختلف نشان داده شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، با وجود آن‌که ارتعاش کلی ورق بدون تحریک الکتریکی، با فرکانس تحریک مکانیکی انجام می‌گیرد، نوسانات گذرای نامیرا با فرکانس طبیعی اول ورق نیز بر نوسان اصلی ورق سوارند و به همین دلیل، پاسخ ورق به فرم هارمونیک ساده نیست. ولتاژ الکتریکی مشبّت، باعث اغتشاشاتی عموماً با انحراف مثبت و ولتاژ الکتریکی منفی، موجب نوساناتی با انحراف عموماً منفی نسبت به سیکنال اصلی شده‌اند.

۳.۲.۴. کنترل فعال ارتعاشات ورق
برای بررسی اثر کنترل مداربسته‌ی ارتعاشات ورق، از دو لایه‌ی پیزوالکتریک – یک لایه‌ی حس‌گر در بالای مجموعه و یک لایه‌ی محرک در زیر لایه‌های ورق کامپوزیت – استفاده شده است. در مثال کنونی، مقدار ضریب تقویت ولتاژ حس‌گر برای اعمال

پابند

1. Functionally graded material

منابع

- He, X.Q.; Ng, T.Y.; Sivashanker, S.; Liew, K.M. "Active control of FGM plates with integrated piezoelectric sensors and actuators", *International journal of solids and structures*, **38**, pp. 1641-1655 (2001).
- Wu, X.H.; Chen, C.Q.; Shen, Y.P.; Tian, X.G. "A high order theory for functionally graded piezoelectric shells", *International Journal of Solids and Structures*, **39**, pp. 5325-5344 (2002).
- Yang, J.; Kitipornchai, S.; Liew, K.M. "Large amplitude vibration of thermo-electro-mechanically stressed FGM laminated plates", *Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.*, **192**, pp. 3861-3885 (2003).
- Huang, X.L.; Shen, H.S. "Nonlinear free and forced vibration of simply supported shear deformable laminated plates with piezoelectric actuators", *International Journal of Mechanical Sciences*, **47**, pp. 187-208 (2005).
- Reddy, J.N. *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells theory and analysis*, 2nd ed., CRC Press (2004).
- Saravacos, D.A.; Heyliger, P.R.; Hopkins, D.A. "Layerwise mechanics and Finite element for the dynamics analysis of piezoelectric composite plates", *Int J Solids Struct*, **34** (3), pp. 359-78 (1997).